



Наука в Сибири

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

26 июля 2012 года • 52-й год издания • № 28—29 (2863—2864) • <http://www.sbras.ru/HBC/> • Цена 7 руб.

Этнонациональные процессы в современном мире

20—21 сентября 2012 года в рамках реализации плана мероприятий, посвящённых Году единения и дружбы народов Республики Саха (Якутия), в городе Якутске пройдет Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современный мир и этнонациональные процессы».

В настоящее время Правительство Российской Федерации в ряду своих приоритетных задач особо выделяет решение проблем этносоциальной стабилизации общества. Напомним, что 7 июня 2012 года Указом Президента РФ В.В. Путина был образован Совет по национальным отношениям, основной задачей которого стало обеспечение взаимодействия субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

Современный этап развития российского общества характеризуется возникновением новых ценностей, ориентиров. Формируется единое социально-духовное глобальное пространство, связывающее различные культуры и народы. Одновременно существующим явлением становятся тенденции — поиска путей самоидентификации в глобализирующемся мире, стремления народов сохранить свою уникальность и своеобразие, выражающиеся в культуре, языке, религии и возрождении национальных традиций. Все эти процессы, и их последствия представляют сегодня особый интерес как для учёных, так и для широкой общественности.

На будущей конференции учёные Якутского научного центра СО РАН, представители субъектов РФ, национальных общин, министерств и ведомств, специалисты и преподаватели вузов примут участие в обсуждении современных процессов в сфере этнонациональных отношений, государственно-правовых вопросов этнонационального развития, а также социально-экономических основ взаимоотношений наций, этносов, народов Севера в контексте модернизации общества. Запланированы дискуссии по поводу острых проблем и конфликтов, существующих современному обществу. В этой связи предстоит найти точки сближения и соприкосновения учёных и специалистов разных направлений для плодотворного диалога и конструктивного сотрудничества, нацеленных на глубокий анализ и решение острых проблем современности.

В руководство оргкомитета конференции вошли заместитель председателя ЯНЦ СО РАН д.э.н. А.А. Пахомов, заместитель председателя Госкомитета Республики Саха (Якутия) по инновационной политике и науке А.Д. Сафронов, заведующий кафедрой философии ЯНЦ СО РАН, д.филос.н. профессор Е.М. Махаров, а также президент Академии наук РС(Я) д.г.-м.н. профессор И.И. Колодезников.

Пресс-служба ЯНЦ СО РАН

Следующий номер «НВС» выйдет 9 августа.



Визит делегации «Росэлектроники»

21 июля представительная делегация Минпромторга РФ и ОАО «Росэлектроника» посетила Сибирское отделение РАН.

В составе делегации — директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ А.С. Якунин, генеральный директор ОАО «Росэлектроника» А.В. Зверев, ОАО «Московский завод «Сапфир» Д.А. Гиндин, ОАО «Государственный институт прикладной оптики» (г. Казань) В.П. Иванов, а также директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов В.И. Исюк.

В обстоятельной беседе с председателем Отделения академиком А.Л. Асеевым состоялось обсуждение задач развития отечественной электронной компонентной базы, поставленных Правительством РФ и сформулированных в последних поручениях Президента РФ В.В. Путина и вице-преьера Д.О. Рогозина. Высокую оценку со стороны гостей получил потенциал институтов СО РАН по развитию отечественной микро-, опто-, СВЧ- и наноэлектроники, полимерной (пластиковой) электроники, а также работы по созданию новых материалов для высокоэффективных аккумуляторов электрической энергии и суперконденсаторов и энергосберегающих систем на их основе.

При посещении Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН гости подробно ознакомились с новейшими разработками института: квантовыми наногетероструктурами для различных применений, большеформатными матрицами для инфра-

красных фотоприемников и опико-электронными системами на их основе, биосенсорами на основе нанопроволочных транзисторов, однофотонными излучателями для систем передачи информации, лавинными диодами, кремниевыми наностандартами, системой квантовой криптографии и многими другими.

Необходимо отметить, что институты СО РАН и предприятия «Росэлектроники» связывают многие годы успешной совместной работы. Признано, что научные и прикладные результаты институтов Сибирского отделения РАН с учётом уникальности научно-образовательной и инновационной систем новосибирского Академгородка, опыта взаимодействия с предприятиями отрасли создают необходимые условия для быстрого решения поставленных задач. В результате визита намечены конкретные меры по существенному усилению работ в области современной электроники в системе Сибирского отделения РАН, на территории новосибирского Академгородка, в целом в Сибирском регионе, включая институты СО РАН и предприятия отрасли в Новосибирске, Томске, Красноярске и Иркутске.

Наш корр.

На снимках В. Яковлева:

— А.В. Зверев и А.Л. Асеев;

— в лаборатории ИФП (А.Л. Асеев, А.В. Зверев,

Э.В. Скубневский, В.И. Исюк, А.С. Якунин, М.В. Якушев).

